



中国科学院科学出版基金资助出版

半导体学报

(BANDAOTI XUEBAO)

第 18 卷 第 8 期 1997 年 8 月

目 次

MBE 生长应变 $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x/\text{Si}$ MQW 结构中 Ge 分布的计算	司俊杰 杨沁清 王启明 (561)
Si 衬底上用反应蒸发法制备 AlN 单晶薄膜	张 伟 张仕国 袁 骏 (568)
GaAs/GaAlAs 量子阱双色红外探测器的光电性质的研究	崔丽秋
江德生 张耀辉 吴文刚 刘 伟 宋春英 李月霞 孙宝权 王若桢 (573)	
$\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$ 外延层结构参数的椭圆光谱表征技术研究	张瑞智 罗晋生 (581)
借助硅片减薄重掺硅间隙氧含量低温(10K)红外测量	王启元
王 俊 韩秀峰 邓惠芳 王建华 咎育德 蔡田海 郁元桓 林兰英 (587)	
InP 系列多薄层异质结构材料光致发光谱温度特性的实验研究	丁国庆 (592)
用 Van der Pauw 法研究硼重掺杂金刚石薄膜电学性质	
陈光华 张兴旺 季亚英 (598)	
红外区熔再结晶 SOI $\text{Ge}_x\text{Si}_{1-x}$ 合金沟道 P-MOSFET 的研究	
付 军 栾洪发 田立林 钱佩信 周均铭 (603)	
基于线网类型分析的过点分配算法	李 江 洪先龙 乔长阁 蔡懿慈 (609)
真空微电子三极管直流特性及栅阴极电容的计算机模拟	
秦 明 黄庆安 魏同立 (616)	
微尖场致发射三极管的 FDM-NOCCS 算法模拟	
汪 琛 尹涵春 王保平 童林凤 (621)	
单电子晶体管放大器的数值分析	沈 波 蒋建飞 (626)
研究快报	
InAs/GaAs 自组织生长量子点结构中浸润层光致发光研究	
吕振东 徐仲英 郑宝真 许继宗 王玉琦 王建农 葛惟钡 (631)	
Two-Dimensional Simulation of Interface States Effect on AlGaAs/GaAs HEMT ...	
Zhang Xinghong(张兴宏), Yang Yufen(杨玉芬) and Wang Zhanguo(王占国) (636)	